

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Мармалюк Александр Анатольевич
2	Дата рождения (полная)	27.03.1970
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор технических наук (специальность – 05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 1, https://www.polyus.info/ , bereg@niipolyus.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полус» имени М.Ф. Стельмаха»
	Ведомственная принадлежность организации	ГК «Ростех»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научно-технический центр
	Должность	Начальник НТЦ
7	Основные публикации в области диссертационного исследования:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. D.A. Veselov, N.A. Pikhtin, S.O. Slipchenko, I.K. Kirichenko, A.A. Podoskin, N.V. Shuvalova, N.A. Rudova, L.S. Vavilova, M.G. Rastegaeva, T.A. Bagaev, V.N. Svetogorov, A.A. Padalitsa, Yu.L. Ryaboshtan, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk Implementation of energy barrier layers for 1550 nm high-power laser diodes // J. Luminescence, 263 (2023) 120164 2. Y. Kirichenko (Bobretsova), D. Veselov, A. Klimov, S. Slipchenko, N. Shuvalova, A. Lyutetsky, N. Pikhtin, A. Marmalyuk, V. Svetogorov, Y. Ryaboshtan, M. Ladugin Brightness of AlGaInAs/InP Multimode Diode Lasers with Different Aperture Widths // Nanomaterials, 2023, 13(20), 2746 3. В.И. Козловский, С.М. Женишбеков, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов, А.Ю. Андреев, И.В. Яроцкая, А.А. Мармалюк Исследование полупроводникового дискового лазера, излучающего на длине волны 780 нм, на основе гетероструктуры с квантовыми ямами Al_xGa_{1-x}As/Al_yGa_{1-y}As при оптической накачке с различной длиной волны излучения // Квантовая электроника, 53, № 8 (2023) 636-640 4. S.O. Slipchenko, A.A. Podoskin, D.A. Veselov, V.A. Strelets, N.A. Rudova, N.A. Pikhtin, T.A. Bagaev, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk, P.S. Kop'ev, Tunnel-Coupled Laser Diode Microarray as a kW-Level 100-ns Pulsed Optical Power Source ($\lambda = 910$ nm) // IEEE Photonics Technology Letters, vol. 34, no. 1 (2022) 35-38 5. А. И. Данилов, А. В. Иванов, В. П. Коняев, Ю. В. Курнявко, М. А. Ладугин, А. В. Лобинцов, А. А. Мармалюк, С. М. Сапожников, В. А. Симakov Полупроводниковые лазеры с улучшенными излучательными характеристиками // Квантовая электроника, 52:12 (2022), 1079–1087 6. Слипченко С.О., Романович Д.Н., Гаврина П.С., Веселов Д.А., Багаев Т.А., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Пихтин Н.А. Мощные импульсные полупроводниковые лазеры (910 нм) мезаполосковой конструкции со сверхширокой излучающей апертурой на основе туннельно-связанных гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs // Квантовая электроника. (2022) Т. 52. № 2. С. 174-178. 7. Н. А. Волков, К. Ю. Телегин, Н. В. Гультиков, Д. Р. Сабитов, А. Ю. Андреев, И. В. Яроцкая, А. А. Падалица, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк, Л. И. Шестак, 	

	<p>А. А. Козырев, В. А. Панарин. Улучшение параметров вольт-амперной характеристики полупроводниковых лазеров InGaAs/AlGaAs/GaAs ($\lambda = 940\text{--}980$ нм) с расширенным асимметричным волноводом // Квантовая электроника, 52:2 (2022), 179–181</p> <p>8. Т. А. Багаев, Н. В. Гультиков, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк, Ю. В. Курнявко, В. В. Кричевский, А. М. Морозюк, В. П. Коняев, В. А. Симаков, С. О. Слипченко, А. А. Подоскин, Н. А. Пихтин, А. Е. Казакова, Д. Н. Романович, В. А. Крючков. Мощные полупроводниковые гибридные импульсные лазерные излучатели в диапазоне длин волн 900–920 нм // Квантовая электроника, 51:10 (2021), 912–914</p> <p>9. Ю. К. Бобрецова, Д. А. Веселов, А. А. Подоскин, Н. В. Воронкова, С. О. Слипченко, М. А. Ладугин, Т. А. Багаев, А. А. Мармалюк, Н. А. Пихтин. Экспериментальная методика исследования оптического поглощения в волноводных слоях полупроводниковых лазерных гетероструктур // Квантовая электроника, 51:2 (2021), 124–128</p> <p>10. Аслаян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Мирзаи С.С., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А. Исследование напряженности внутренних электрических полей в активной области светодиодных структур на основе InGaN/GaN с разным числом квантовых ям методом спектроскопии электропропускания // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. №4. С. 420–425.</p> <p>11. Аслаян А.Э., Авакянц Л.П., Червяков А.В., Туркин А.Н., Курешов В.А., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А. Фотореверсивный ток в светодиодных гетероструктурах на основе InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. №3. С. 292–295.</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты